

66183**PROTON RADIATION TOLERANT OPTOCOUPLER**
(Single Channel, Electrically Similar to 4N49)**Mii**OPTOELECTRONIC PRODUCTS
DIVISION

REVISION C 5/6/02

Features:

- High Reliability
- Base lead provided for conventional transistor biasing
- Rugged package
- Stability over wide temperature
- +1000V electrical isolation

Applications:

- Eliminate ground loops
- Level shifting
- Line receiver
- Switching power supplies
- Motor control

DESCRIPTION

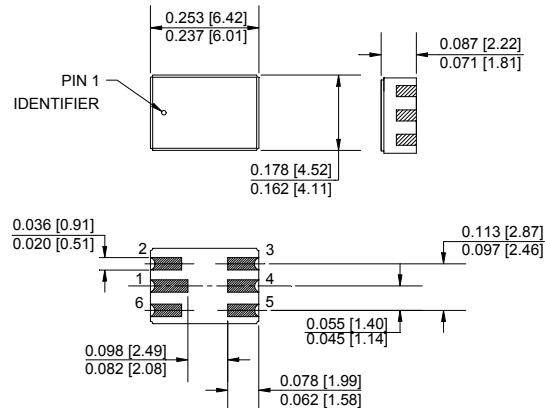
The **66183** is a single channel device electrically similar to the 4N49. This product has been designed to be more tolerant to proton radiation. The 66183 optocoupler is packaged in a hermetically sealed 6 pin leadless chip carrier (LCC). This device can be supplied to customer specifications as well as tested in accordance with MIL-PRF-19500 to Class S level.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

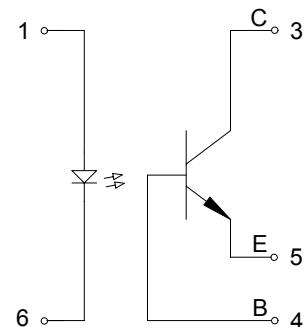
Input to Output Voltage	1kV
Emitter-Base Voltage	7V
Collector-Emitter Voltage (Value applies to emitter-base open-circuited & the input-diode equal to zero)	40V
Collector-Base Voltage	45V
Reverse Input Voltage	2V
Input Diode Continuous Forward Current at (or below) 65°C Free-Air Temperature (see note 1)	50mA
Peak Forward Input Current (Value applies for $t_{w} \leq 1\mu s$, PRR < 300 pps)	1A
Continuous Collector Current	50mA
Continuous Transistor Power Dissipation at (or below) 25°C Free-Air Temperature (see Note 2)	300mW
Storage Temperature.....	-55°C to +150°C
Operating Free-Air Temperature Range	-55°C to +100°C
Lead Solder Temperature (10 seconds max.)	240°C

Notes:

1. Derate linearly to 100°C free-air temperature at the rate of 0.80 mW/°C above 25°C.
2. Derate linearly to 100°C free-air temperature at the rate of 3 mW/°C above 25°C.

Package Dimensions

ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]

Schematic Diagram

ELECTRICAL CHARACTERISTICS $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS	NOTE
Input Diode Static Reverse Current	I_R			100	μA	$V_R = 3\text{V}$	
Input Diode Static Forward Voltage -55°C	V_F	1.0		2.2	V	$I_F = 10\text{mA}$	
Input Diode Static Forward Voltage $+25^\circ\text{C}$	V_F	0.8	1.8	2.0	V	$I_F = 10\text{mA}$	
Input Diode Static Forward Voltage $+100^\circ\text{C}$	V_F	0.8		2.2	V	$I_F = 10\text{mA}$	

OUTPUT TRANSISTOR $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS	NOTE
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	45			V	$I_C = 100\mu\text{A}, I_B = 0, I_F = 0$	
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	40			V	$I_C = 1\text{mA}, I_B = 0, I_F = 0$	
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	2			V	$I_C = 0\text{mA}, I_E = 100\mu\text{A}, I_F = 0$	
Off-State Collector Current $+100^\circ\text{C}$	I_{CEO}			100	nA	$V_{CE} = 20\text{V}, I_F = 0\text{mA}, I_B = 0$	
	I_{CEO}			100	μA	$V_{CE} = 20\text{V}, I_F = 0\text{mA}, I_B = 0$	

COUPLED CHARACTERISTICS $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS	NOTE
On State Collector Current	$I_{C(ON)}$	2.0			mA	$V_{CE} = 5\text{V}, I_F = 1\text{mA}, I_B=0$	
On State Collector Current $+100^\circ\text{C}$	$I_{C(ON)}$	2.0			mA	$V_{CE} = 5.0\text{V}, I_F = 2\text{mA}, I_B=0$	
On State Collector Current -55°C	$I_{C(ON)}$	2.8			mA	$V_{CE} = 5\text{V}, I_F = 2\text{mA}, I_B=0$	
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$			0.3	V	$I_F = 2\text{mA}, I_C = 2\text{mA}$	
Input to Output Internal Resistance	R_{IO}	10^{11}			Ω	$V_{IN-OUT} = 1000\text{V}$	1
Input to Output Capacitance	C_{IO}		2.5	5	pF	$f = 1\text{MHz}, V_{IN-OUT} = 1000\text{V}$	1
Rise Time-Phototransistor Operation	t_r		10	25	μs	$V_{CC} = 10\text{V}, I_F = 10\text{mA}, R_L = 100\Omega, I_B = 0$	
Fall Time-Phototransistor Operation	t_f		10	25	μs	$V_{CC} = 10\text{V}, I_F = 10\text{mA}, R_L = 100\Omega, I_B = 0$	

NOTES:

- These parameters are measured between all phototransistor leads shorted together and with both input diode leads shorted together.
- This parameter must be measured using pulse techniques ($t_W = 100\mu\text{s}$ duty cycle $\leq 1\%$).

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS:

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNITS
Input Current, Low Level	I_{FL}	0	90	μA
Input Current, High Level	I_{FH}	2	10	mA
Supply Voltage	V_{CE}	5	10	V
Operating Temperature	T_A	-55	100	$^\circ\text{C}$

SELECTION GUIDE

PART NUMBER	PART DESCRIPTION
66183-001	Single channel proton radiation tolerant optocoupler - commercial
66183-101	Single channel proton radiation tolerant optocoupler – screened to JAN
66183-103	Single channel proton radiation tolerant optocoupler – screened to JANTX
66183-105	Single channel proton radiation tolerant optocoupler – screened to JANTXV

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок

AMD

ANALOG DEVICES

BOURNS

Coilcraft
The world's largest manufacturer of magnetic components

élan tec
Semiconductor, Inc.

HARRIS

infineon

JRC

MICREL
Innovation through Technology™

MOTOROLA

nichicon

PHILIPS

ROHM

ST SGS-THOMSON
Microelectronics

Sipex

TAIYO YUDEN

TOKO

ZILAS

Winbond
Electronics Corp.

Allegro
MicroSystems, Inc.

ATMEL

BURR - BROWN
BB

EXAR

HITACHI
Inspire the Next

intel

Lattice
Semiconductor Corporation

muRata
Leader in Electronics

OKI

QUALCOMM

SAMSUNG

SHARP

SONY

TDK

TOSHIBA

XORX

ALTERA

AVX
Components

CATALYST

CYPRESS
TECHNOLOGY

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR

HOLTEK

International IOR Rectifier

LINEAR TECHNOLOGY
mitsubishi

National Semiconductor

ON Semiconductor
UN

REALTEK
Radish Semiconductor Corp.

SANYO

SHINDENGEN

SS

TECCOR
ELECTRONICS

TUNDRA

XILINX

Amphenol

Bay Linear

CIRRUS LOGIC

DALLAS

FUJITSU

IDT

intersil

MAXIM

molex

NEC

Panasonic

RENESAS

SII
Silico Instruments Inc.

SIEMENS

ST

TEXAS INSTRUMENTS

VISHAY

ZETEX
SEMICONDUCTORS



гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>